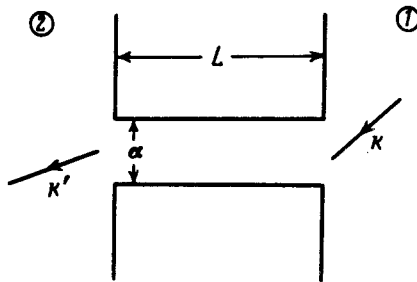


## КВАНТОВАЯ ПРОВОДИМОСТЬ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО МИКРОКОНТАКТА

И.Б.Левинсон

Вычислена проводимость баллистического микроконтакта в виде длинного мостика с учетом дифракции электрона на переходе от мостика к массивному берегу. Показано, что зависимость проводимости от ширины мостика имеет вид сглаженной лестницы со ступеньками высоты  $e^2/\pi\hbar$ .

В последние месяцы большое внимание привлекают эксперименты <sup>1, 2</sup>, в которых было обнаружено квантование проводимости шарвиновского микроконтакта в  $2D$  электронном газе гетероперехода GaAs/GaAlAs: с увеличением ширины контактной перемычки  $d$  проводимость  $G$  растет не монотонно, а "по лестнице" со ступеньками высоты  $e^2/\pi\hbar$ . Интерпретация этого эффекта в <sup>1, 2</sup> предполагает, что перемычка имеет вид длинной полоски (см. рисунок). С увеличением  $d$  увеличивается число уровней квантования в направлении  $d$ , лежащих ниже уровня Ферми в берегах 1 и 2 (число каналов проводимости  $N$ ). Вклад каждого канала в  $G$ , согласно <sup>1, 2</sup>, есть  $e^2/\pi\hbar$ , причем каналы не взаимодействуют.



Ступеньки наиболее отчетливы при малых  $G$ , когда  $N$  невелико, т.е. когда  $d \sim \lambda_F = 2\pi/k_F$ , где  $k_F$  – фермиевский импульс. В этих условиях при вычислении  $G$  следует принимать во внимание дифракцию электронной волны в процессе ее прохождения из одного берега в другой. Это обстоятельство в <sup>1, 2</sup> не учитывалось.

Согласно <sup>3</sup> проводимость баллистического микроконтакта с учетом дифракции

$$G = e^2 N_F \langle \theta(\mathbf{v}_k) \sigma_k v_k \rangle. \quad (1)$$

Здесь  $N_F$  – плотность состояний на поверхности Ферми,  $\sigma_k = P/I_0$  – поперечник прохождения плоской волны  $\mathbf{k}$ , приходящей из берега 1 в область микроконтакта ( $I_0$  – плотность потока в волне  $\mathbf{k}$ ,  $P$  – полный поток, вышедший в берег 2). Скобки обозначают усреднение по поверхности Ферми, множитель  $\theta$  ограничивает интегрирование той областью, где скорость электрона  $\mathbf{v}_k$  направлена в сторону микроконтакта. Формула (1) может быть получена из результатов работы <sup>4</sup>.

Когда микроконтакт имеет вид длинного волновода ( $L \gg d$ ),  $\sigma_k$  можно выразить через величины, описывающие дифракцию на конце полубесконечного волновода. В случае одного канала проводимости ( $N = 1$ ) получаем:

$$\sigma_k = \frac{|A_k|^2}{|1 - R^2 e^{2iqL}|^2} \int d\sigma_{k'} |T_{k'}|^2. \quad (2)$$

Здесь  $2\pi/q$  – длина волноводной волны,  $R$  – коэффициент ее отражения от открытого конца волновода,  $T_{k'}$  – амплитуда волны  $\mathbf{k}'$ , излученной волноводной волной единичной амплитуды,  $A_k$  – амплитуда волноводной волны, возбужденной волной  $\mathbf{k}$  единичной амплитуды.

Подставляя (2) в (1), выражая  $A_k$  через  $T_k$  по принципу взаимности, а интеграл по углам от  $|T_k|^2$  через  $1 - |R|^2$  из сохранения энергии, получим:

$$G = \frac{e^2}{\pi \hbar} \frac{(1 - |R|^2)^2}{|1 - R^2 e^{2iqL}|^2} \equiv \frac{e^2}{\pi \hbar} g. \quad (3)$$

Отметим, что формула (3) справедлива независимо от того является ли волновод двухмерным или трехмерным. Полагая  $R = |R| e^{i\theta}$  и  $1 - |R|^2 = |T|^2$  имеем:

$$g = \frac{|T|^4}{4(1 - |T|^2) \sin^2 \varphi + |T|^4}, \quad \varphi = \theta + qL. \quad (4)$$

Отсюда видно, что  $g \leq 1$ . Фактор  $g = 1$  в двух случаях: когда нет дифракции на открытом конце волновода ( $R = 0$ ) и при резонансном прохождении, когда набег фазы на длине волновода компенсируется фазой коэффициента отражения ( $\sin \varphi = 0$ ).

Для 2D-геометрии, изображенной на рисунке,  $N = 1$ , когда  $1/2 < d/\lambda_F < 1$ . При этом  $q^2 = k_F^2 - (\pi/d)^2$ , а коэффициент отражения  $R$  может быть заимствован из решения задачи об излучении в полупространство электромагнитной волны  $H_{10}$  в волноводе с бесконечно высокими стенками<sup>5</sup>. На пороге  $d = \lambda_F/2$  ( $q = 0$ ) имеем  $|R|^2 = 1$ , но затем, с увеличением  $d$ ,  $|R|^2$  быстро падает, так что  $|R|^2 < 0,01$  уже при  $d > 0,7 \lambda_F$ . Поэтому в зависимости  $G$  от  $d$  при некотором удалении от порога должно иметь место плато  $G = e^2/\pi \hbar$ , что и наблюдается. С другой стороны, вблизи порога зависимость  $G$  от  $d$  должна описываться последовательностью узких резонансных пиков, что не наблюдается.

Возможной причиной исчезновения пиков может быть температурное уширение поверхности Ферми. Если  $T \gg \hbar v_F/L$ , то

$$G = \frac{e^2}{\pi \hbar} \frac{1 - |R|^2}{1 + |R|^2} \equiv \frac{e^2}{\pi \hbar} \bar{g}, \quad (5)$$

что соответствует плавному выходу на плато. Важно отметить, что  $\bar{g}$  слабо зависит от характера сочленения волновода с берегом. В этом можно убедиться, если для сравнения вычислить  $\bar{g}$ , заимствуя  $R$  из задачи об излучении волны  $H_{10}$  в неограниченное пространство<sup>6</sup>.

Обобщение (2) на случай  $N > 1$  тривиально, хотя и очень громоздко. Из получающейся формулы видно, что, вообще говоря,  $G \neq (e^2/\pi \hbar)N$ , так как каналы проводимости взаимодействуют (из-за того, что при отражении от конца волновода волны разного типа трансформируются друг в друга) и проводимость каждого канала не равна  $e^2/\pi \hbar$ . Однако эти эффекты существенны только вблизи порогов появления новых волноводных волн. Например, в интервале ширины  $1 < d/\lambda_F < 3/2$  кроме основной волны  $n = 1$ , симметричной относительно оси волновода, распространяется антисимметричная волна  $n = 2$ . Из-за разной симметрии волны  $n = 1$  и  $n = 2$  не преобразуются друг в друга при отражении от конца волновода, т.е. эти два канала дают аддитивные вклады в проводимость:  $G = G_1 + G_2$ . При этом  $G_1$  и  $G_2$  определяются формулами типа (3) или (5). Из<sup>6</sup> можно видеть, что в рассматриваемом интервале коэффициент отражения  $|R_{11}|^2 < 10^{-3}$ , так что  $G_1 \approx e^2/\pi \hbar$ . Что касается  $R_{22}$ , то  $|R_{22}|^2 = 1$  на пороге  $d = \lambda_F$ , но затем быстро падает. Уже при  $d > 1,25 \lambda_F$  имеем  $|R_{22}|^2 < 10^{-2}$ . Иначе говоря,  $G_2$  растет от нуля и выходит на плато  $G_2 \approx e^2/\pi \hbar$ . В интервале ширины  $3/2 < d/\lambda_F < 2$  появляется симметричная волна  $n = 3$ . При отражении на конце волновода волны  $n = 1$  и  $n = 3$  преобразуются друг в друга и поэтому вклады этих двух каналов в  $G$  не аддитивны. Однако уже при  $d > 1,75 \lambda_F$  коэффициенты отражения и преобразования меньше процента, так что  $G$  выходит на плато  $3(e^2/\pi \hbar)$ .

В условиях экспериментов<sup>1,2</sup>  $\lambda_F \approx 400 \text{ \AA}$ . Что касается  $L$ , то его оценить труднее, так как профиль потенциала, созданного затвором и определяющего фактическую форму пере-

мычки, неизвестен. В любом случае  $L$  не превышает литографических размеров зазора в затворе, так что  $L \lesssim 1$  мкм. Длина пробега относительно упругого рассеяния, оцененная по подвижности, в лучших образцах около 10 мкм, так что микроконтакты действительно баллистические. Однако при  $L \lesssim 1$  мкм и  $T \lesssim 1$  К температурное уширение уровня Ферми недостаточно для размытия резонансных пиков. Другой возможной причиной размытия может быть неоднородность  $d$  по длине волновода.

Автор благодарен Д.Е.Хмельницкому, который привлек его внимание к статье <sup>1</sup>, и Г.Тимпу, указавшему на статью <sup>2</sup>, а также Ю.В.Шарвину, В.С.Эдельману и А.В.Хаецкому за полезные замечания по работе.

#### Литература

1. *Van Wees B.J., Van Houten H., Beenakker C.W.J. et al.* Phys. Rev. Lett., 1988, 60, 848.
2. *Wharam D.A., Thornton T.J., Newbury R. et al.* J. Phys. C: Solid State Phys., 1988, 21, L209.
3. *Вдовин Е.Е., Касумов А.Ю., Копецкий Ч.В., Левинсон И.Б.* ЖЭТФ, 1987, 92, 1026.
4. *Ицкович И.Ф., Шехтер Р.И.* ФНТ, 1985, 11, 373.
5. Справочник по волноводам. Под ред. Я.Н.Фельда. М.: Сов. радио, 1952.
6. *Вайнштейн Л.А.* Дифракция электромагнитных и звуковых волн на открытом конце волновода. М.: Сов. радио, 1953.

Институт проблем технологии микроэлектроники  
и особочистых материалов  
Академии наук СССР

Поступила в редакцию  
21 июля 1988 г.